

Содержание

● Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Хлудков С.С., Прудаев И.А., Новиков В.А., Толбанов О.П., Ивонин И.В.

Исследование процесса распада пересыщенного твердого раствора GaAs:Fe методом сканирующей зондовой микроскопии 1009

Бордовский Г.А., Гладких П.В., Кожокар М.Ю., Марченко А.В., Серегин П.П., Теруков Е.И.

Двухэлектронные центры олова, образующиеся в стеклообразных халькогенидах мышьяка в результате ядерных превращений 1012

Ярыкин Н.А., Weber J.

Взаимодействие примеси меди с радиационными дефектами в легированном бором кремнии 1017

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Борщ Н.А., Переславцева Н.С., Курганский С.И.

Электронная структура и спектральные характеристики Cd-замещенных германиевых клатратов 1021

Остапов С.Э., Фрасуняк В.М., Жихаревич В.В.

Исследование основных зонных параметров HgMnZnTe 1027

Татохин Е.А., Каданцев А.В., Бормонтов А.Е., Задорожний В.Г.

Статистический метод релаксационной спектроскопии глубоких уровней в полупроводниках 1031

Анисимова Н.И., Бордовский В.А., Грабко Г.И., Кастро Р.А.

Особенности механизма переноса заряда в структурах на основе тонких слоев триселенида мышьяка, модифицированных висмутом 1038

Алиев Ф.Ф., Джафаров М.Б., Аскерова Г.З., Годжаев Э.М.

Рассеяние электронов на акцепторных центрах в p -Ag₂Te при низких температурах 1042

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Киселюк М.П., Власенко А.И., Генцарь П.А., Вуйчик Н.В., Заяц Н.С., Кругленко И.В., Литвин О.С., Криськов Ц.А.

Оптические свойства тонких пленок GaSe/ n -Si(111) . . . 1046

Гольдман Е.И., Гуляев Ю.В., Ждан А.Г., Чучева Г.В.

Прямое туннелирование электронов в структурах Al- n^+ -Si-SiO₂- n -Si в режиме нестационарного обеднения поверхности полупроводника основными носителями заряда 1050

Рудинский М.Э., Гуткин А.А., Брунков П.Н.

Вольт-фарадные характеристики системы электролит- n -InN и электронные состояния на границе раздела . 1053

Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Теруков Е.И.

Создание и фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных структур In/ p -Ag₃AsS₃ 1059

Иванов А.М., Котина И.М., Ласаков М.С., Строкан Н.Б., Тухконен Л.М.

Барьеры на p -кремнии типа металл-диэлектрик-полупроводник с нанотолщинным диэлектриком из нитрида алюминия 1064

● Низкоразмерные системы

Ремнев М.А., Катеев И.Ю., Елесин В.Ф.

Влияние спейсерных слоев на вольт-амперные характеристики резонансно-туннельного диода 1068

Маслова Н.Е., Антоновский А.А., Жигунов Д.М., Тимошенко В.Ю., Глебов В.Н., Семиногов В.Н.

Исследование нанокристаллов кремния в слоях субоксида кремния методом комбинационного рассеяния света . . . 1074

● Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Белогорохов И.А., Мамичев Д.А., Дронов М.А., Пушкарев В.Е., Томилова Л.Г., Хохлов Д.Р.

Комбинационное рассеяние света в органических полупроводниках на основе молекул дифталоцианина эрбия и хлорсодержащих молекул трифталоцианина лютеция и европия 1078

Талалаев В.Г., Сеничев А.В., Новиков Б.В., Tomm J.W., Elsaesser T., Захаров Н.Д., Wetter P., Gösele U., Самсоненко Ю.Б., Цырлин Г.Э.

Туннельно-инжекционные структуры InGaAs с наномостиками: перенос возбуждения и кинетика люминесценции . 1084

Константинова Е.А., Гайворонский В.Я., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.

Исследование спиновых центров в нанокристаллическом диоксиде титана с высокой степенью фотокаталитической активности 1093

Терентьев Я.В., Мухин М.С., Соловьев В.А., Семенов А.Н., Мельцер Б.Я., Усикова А.А., Иванов С.В.

Исследование механизмов фото- и электролюминесценции в квантово-размерных гетероструктурах InSb/InAs 1098

Зиминов А.В., Полевая Ю.А., Юрре Т.А., Рамш С.М., Мездрогина М.М., Полетаев Н.К.

Фотолюминесценция нитрозамещенных фталоцианинов европия (III) 1104

Ременюк А.Д., Звонарева Т.К., Серенков И.Т., Сахаров В.И., Perova T.S., Vaselyuk J.

Исследование рамановских спектров и спектров обратного резерфордского рассеяния пленок аморфного углерода, модифицированного платиной 1108

• **Физика полупроводниковых приборов**

Бобренко Ю.Н., Павелец С.Ю., Павелец А.М., Киселюк М.П., Ярошенко Н.В.

Эффективные фотоэлектрические преобразователи ультрафиолетового излучения на основе ZnS и CdS с низкоомными поверхностными слоями 1114

Минтаиров С.А., Андреев В.М., Емельянов В.М., Калюжный Н.А., Тимошина Н.К., Шварц М.З., Лантратов В.М.

Исследование диффузионных длин неосновных носителей заряда в фотоактивных слоях многопереходных солнечных элементов 1118

Авакянц Л.П., Боков П.Ю., Червяков А.В., Чужас А.В., Юнович А.Э., Васильева Е.Д., Бауман Д.А., Уелин В.В., Явич Б.С.

Интерференционные эффекты в спектрах электроотражения и электролюминесценции светодиодных гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN 1124

Tsai Jung-Hui, Lour Wen-Shiung, Guo Der-Feng, Liu Wen-Chau, Wu Yi-Zhen, Dai Ying-Feng

InP/GaAsSb type-II DHBTs with GaAsSb/InGaAs superlattice-base and GaAsSb bulk-base structures 1130

• **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Грехов И.В., Костина Л.С., Аргунова Т.С., Белякова Е.И., Рожков А.В., Шмидт Н.М., Юсупова Ш.А., Же J.H.

Структурные и электрические свойства подложек SiGe-на изоляторе, сформированных методом прямого сращивания 1135

Середин П.В., Глотов А.В., Домашевская Э.П., Арсентьев И.Н., Винокуров Д.А., Станкевич А.Л., Тарасов И.С.

Релаксация параметров кристаллической решетки и структурное упорядочение в эпитаксиальных твердых растворах $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 1140

Шкумбатюк П.С.

Свойства нитевидных кристаллов ZnO, полученных под действием излучения CO₂-лазера 1147